

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Лебедев Александр Александрович
2	Дата рождения (полная)	10 марта 1959
3	Гражданство	Россия
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, 01.04.10
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре оптоэлектроники
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 Телефон: (812) 297-2245 Факс: (812) 297-1017 Электронная почта: post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru/
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (Ioffe Institute)
	Ведомственная принадлежность организации	Российская академия наук
	Тип организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
	Наименование подразделения	Отделение твердотельной электроники
	Должность	Руководитель отделения
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<p>1. Korolkov, O.M., Kozlovski, V.V., Lebedev, A.A., Sleptsuk, N., Toompuu, J., Rang, T. Low-Temperature Annealing of Lightly Doped n-4H-SiC Layers after Irradiation with Fast Electrons (2019) Semiconductors, 53 (7), pp. 975-978. DOI: 10.1134/S1063782619070133</p> <p>2. Lebedev, A.A., Nikitina, I.P., Seredova, N.V., Poletaev, N.K., Lebedev, S.P., Kozlovski, V.V., Zubov, A.V. A Study of the Influence Exerted by Structural Defects on Photoluminescence Spectra in n-3C-SiC (2019) Technical Physics Letters, 45 (6), pp. 557-559. DOI: 10.1134/S1063785019060117</p> <p>3. Kozlovski, V.V., Vasil'ev, A.E., Davidovskaya, K.S., Lebedev, A.A. Role of the Carbon Sublattice in n-SiC Conductivity Compensation (2019) Journal of Surface Investigation, 13 (1), pp. 140-145. DOI: 10.1134/S1027451019010270</p> <p>4. Strel'chuk, A.M., Kozlovski, V.V., Lebedev, A.A. Radiation-Induced Damage of Silicon-Carbide Diodes by High-Energy Particles (2018) Semiconductors, 52 (13), pp. 1758-1762. DOI: 10.1134/S1063782618130171</p> <p>5. Kozlovski, V.V., Lebedev, A.A., Davydovskaya, K.S., Lyubimova, Y.V. Galvanic and Capacitive Effects in n-SiC Conductivity Compensation by Radiation-Induced</p>	

	<p>Defects (2018) Semiconductors, 52 (12), pp. 1635-1637. DOI: 10.1134/S1063782618120138</p> <p>6. Kozlovski, V.V., Vasil'ev, A.E., Karaseov, P.A., Lebedev, A.A. Formation of Radiation Defects by Proton Braking in Lightly Doped n- and p-SiC Layers (2018) Semiconductors, 52 (3), pp. 310-315. DOI: 10.1134/S1063782618030132</p> <p>7. Lebedev, A.A., Kalinina, E.V., Kozlovski, V.V. Radiation resistance of devices based on SiC (2018) Journal of Surface Investigation, 12 (2), pp. 364-369. Цитирован(ы) 1 раз. DOI: 10.1134/S1027451018020283</p> <p>8. Lebedev, A.A., Davydovskaya, K.S., Strel'chuk, A.M., Yakimenko, A.N., Kozlovski, V.V. Comparison of the effects of electron and proton irradiation on 4H-SiC and Si device structures (2018) Materials Science Forum, 924 MSF, pp. 217-220. Цитирован(ы) 1 раз. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.924.217</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты